



VGF GaAs n型・p型 基板 標準仕様

ドーパント、導電型	Siドーブ (n型)	Znドーブ (p型)
サイズ	2インチ 3インチ 4インチ 6インチ	
面方位	(100)±0.5°	
	(311)A, B±0.5°	(111)A, B±0.5°

キャリア濃度	(cm ⁻³)	(0.5~4.0)×10 ¹⁸	(0.5~5.0)×10 ¹⁹
抵抗率	(Ω.cm)	N/A	N/A
モビリティ	(cm ² /V.S)	(1.0~2.5)×10 ³	50~120
EPD (Ave)	(cm ²)	≦100~5,000	3,000~5,000

直径	(mm)	50.8±0.3	76.2±0.3	100±0.3	150±0.3
厚さ	(μm)	350±25	450±25	625±25	675±25
TTV (両面研磨)	(μm)	≦4	≦4	≦4	≦4
TTV (片面研磨)	(μm)	≦10	≦10	≦10	≦10
Warp	(μm)	≦10	≦10	≦10	≦15
OF長さ	(mm)	17.0±1.0	22.0±1.0	32.5±1.0	ノッチ
IF長さ	(mm)	7.0±1.0	12.0±1.0	18.0±1.0	

レーザーマーク	オプション	
面仕上げ	表面	鏡面研磨 (エピレディ)
	裏面	エッチド/鏡面研磨
梱包形態	個別トレイ/カセット	



VGF GaAs 半絶縁型 基板 標準仕様

ドーパント、導電型	Unドーブ (半絶縁型)	
サイズ	2インチ 3インチ 4インチ 6インチ	
面方位	(100)±0.5°	
	(311)A, B±0.5°	(111)A, B±0.5°

キャリア濃度	(cm ⁻³)	N/A
抵抗率	(Ω.cm)	>1.0×10 ⁷
モビリティ	(cm ² /V.S)	>5,000
EPD (Ave)	(cm ²)	1,500~5,000

直径	(mm)	50.8±0.3	76.2±0.3	100±0.3	150±0.3
厚さ	(μm)	350±25	625±25	625±25	675±25
TTV (両面研磨)	(μm)	≦4	≦4	≦4	≦4
TTV (片面研磨)	(μm)	≦10	≦10	≦10	≦10
Warp	(μm)	≦10	≦10	≦10	≦15
OF長さ	(mm)	17.0±1.0	22.0±1.0	32.5±1.0	ノッチ
IF長さ	(mm)	7.0±1.0	12.0±1.0	18.0±1.0	

レーザーマーク	オプション	
面仕上げ	表面	鏡面研磨 (エピレディ)
	裏面	エッチド/鏡面研磨
梱包形態	個別トレイ/カセット	

※各種ウエハーの仕様はご相談に応じます。